

출력 일자: 2003/6/10

발송번호 : 9-5-2003-021436500

수신 : 서울 중구 남대문로2가 118 해운센터빌딩

발송일자 : 2003.06.09

본관 17층

제출기일 : 2003.08.09

백덕열 귀하

100-770

심사전치

특허청

의견제출통지서

NOTICE OF REQUEST FOR SUBMISSION OF ARGUMENT

출원인 명칭 샤프 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980961371)
주소 일본 오사카후 오사카시 아베노구 나가이쵸 22방 22고
대리인 성명 백덕열 외 1 명
주소 서울 중구 남대문로2가 118 해운센터빌딩본관 17층
출원번호 10-1999-0042677
발명의 명칭 스테틱 랜덤 액세스 메모리 및 반도체장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인 통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제9항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1. 청구항 제9항의 기재에 있어서 『각각 제1웰로 형성되는 채널형성 반도체영역을 가지며 내부 처리를 실행하는 제1MOS트랜지스터』로 기재하고 있으나, 상기 기재의 제1MOS트랜지스터가 내부처리를 실행하는 구체적인 대상 및 제1MOS트랜지스터와 내부처리 실행 대상과의 상호동작관계에 대해 발명의 상세한 설명의 기재에서 불명료합니다.(특허법 제42조제4항제1호)

2.상기와 기재와 같이 기재불비가 있음에도 불구하고 심사해본바, 청구항 제9항은 제1웰로 형성되는 채널형성 반도체 영역을 가지며 내부처리를 실행하는 제1MOS트랜지스터, 제1웰 보다 깊은 제2웰로 형성되는 채널형성 반도체영역을 가지며 외부장치와 직접신호의 송수신을 실행하는 제2MOS트랜지스터를 포함하는 반도체장치를 요지로 하는 것이나, 이는 본원 출원일전에 공지된 일본공개특허공보 평3-22476호(1991.01.30공개)의 반도체기억장치에 있어서 제1웰영역은 제2웰영역 보다 깊이가 낮은 것을 특징으로 하는 반도체기억장치와 그 구성이 유사합니다.(특허법제29조제2항)

[첨부]

첨부1 일본공개특허공보평3-22476호 1부. 끝.

출력 일자: 2003/6/10

2003.06.09

특허청

심사4국

정보심사담당관실

심사관 강철수



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5697 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터